

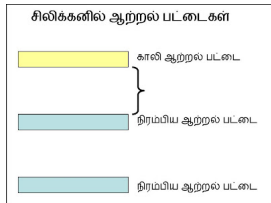
ஒரு திடப் பொருளில் மின்சாரம் எப்படி செல்கிறது, ஒரு பொருள் மின்கடத்தும் பொருளாக அல்லது குறை கடத்தியாக அல்லது மின்கடத்தாப் பொருள் என்பதைத் தீர்மானிப்பது எது என்பதை முன்பு பார்த்தோம். எலக்ட்ரான்கள் ஆற்றல் பட்டிகளில் (energy band) இருக்கும் என்பதையும், ஆற்றல் பட்டி இடைவெளி (band gap) எவ்வளவு என்பதைப் பொறுத்து ஒரு பொருள் மின்கடத்தி அல்லது குறை கடத்தி அல்லது மின்கடத்தாப் பொருள் என்பதை முடிவா செய்யலாம்.

வெப்ப நிலை அதிகரிக்கும் பொழுது குறை கடத்தியில் மின் தடகுறையும் என்பதையும் பார்த்தோம். இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி: சிலிக்கன் என்ற குறை கடத்தியில், பாஸ்பரஸ் என்ற மின்கடத்தாப் பொருளைச் சேர்த்தால், சிலிக்கனின் மின்கடத்தும் திறன் அதிகரிக்கும். அதாவது மின் தடகுறையும். இது நாம் நினைப்பதற்கு நேர்மாறாக இருக்கிறதே, அது ஏன்?

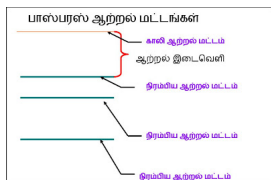
இது தவிர, எல்லா மின்கடத்தாப் பொருளையும் சிலிக்கனில் சேர்த்தால் அதன் மின்கடத்தும் திறன் அதிகரிக்காது. எனவே இது ஒரு பொது விதி அல்ல.

நாம் மீண்டும் மின்சாரம் செல்லும் விதத்தை நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம். ஆற்றல் மட்டத்தில் கீழே இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் எல்லாம் கட்டுற்ற எலக்ட்ரான்கள் (bound electrons). அவைமேலிருக்கும் ஆற்றல் மட்டத்திற்குச் சென்றால் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களாக, சுதந்திரமாக செல்ல முடியும். நடುವில் இருக்கும் இடைவெளியைத் தாண்டி செல்ல அவற்றிற்கு ஆற்றல் தேவை. இந்த இடைவெளி அதிகம் இருந்தால் அது ஒரு மின்கடத்தாப் பொருள். கொஞ்சமாக இருந்தால், குறைகடத்தி. ஏறக்குறைய பூஜ்யமாக இருந்தால் அது மின்கடத்தும் பொருள்.

குறை கடத்தியில் (சிலிக்கனில்), ஆற்றல் பட்டி இருப்பதை ஒரு வரைபடம் மீலம் கீழே கொடுக்கப் பட்டது உள்ளது.

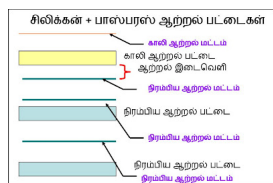


அடுத்து, பாஸ்பரஸ் அணுக்களில் ஆற்றல் மட்டங்கள் இருப்பதை வரைபடத்தில் காணலாம்.



இங்கு ஆற்றல் பட்டிகள் கொடுக்கவில்லை. ஆற்றல் மட்டங்களே உள்ளன. ஏனென்றால், நாம் பாஸ்பரஸ் அணுக்களைச் சேர்க்கும் பொழுது, பல கோடி சிலிக்கன்

இப்போது பாஸ்பரஸ் அணுக்களை, மிகச் சிறிய அளவு சிலிகனில் சேர்த்தால், புதிய ஆற்றல் மட்டங்கள் (அனுமதிக் கப்பட்ட ஆற்றல் மட்டங்கள்) உருவாகும். அவற்றில், கீழே உள்ள மட்டங்களில் எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும். மலேரூக்கும் மட்டங்களில் காலியாக இருக்கும். பாஸ்பரஸ் சேர்க்கப்பட்ட பொழுது எலக்ட்ரான் ஆற்றல் மட்டங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பது கீழே இருக்கிறது.



வஹெ஡ும் பஹஸ் பரஸஹக இரஹந் தஹல் , வஹேலஹை ந஢க் கஹது. வஹெ஡ும் சிலிக் கனஹக இரஹந் தஹல் , கஹஞ் ச஡் ஡ின சஹர஡் க஢தத் த஡ம் . இரண ஢஡ம் சஹே஡ும் பஹழ஡து, ஡ின க஢தத் த஡துதல் அதிகரிக் க஡ம் . ஏனனெ ஢்றஹல் , ஢வ஢ ஢்ரின் ஢ஹ ஢்றல் ஡ட ஢்ங் கள் சஹரியஹக ஢஡ஹகின் ஢்றன. சிலிக் கனின் கஹலி ஢ஹ ஢்றல் ப஢ ஢்ஹைக் க஡ ஢்ருகில் , பஹஸ் பரஸின் ஢்ர஡் பிய ஢ஹ ஢்றல் ஡ட ஢்஡ இரஹக் கி஢்றது. வஹே ஑தஹவது பஹரஹஸை ச஡் ஡ஹ சிலிக் கனில் சஹேத் தஹல் , ஢஢னே ஡ின க஢தத் த஡ம் த்ரின் ஢திக஡ஹக஡ஹ ஢ல் ஢து க஡ற஡஡஡ஹ ஑ன் ஢்ரு சஹல் ஢ ஡஢ியஹது. ஢தன் ஢ஹ ஢்றல் ஡ட ஢்ங் கள் ஑ங் க஡ இரஹக் கின் ஢்றன, ஑வஹ ஢்ர஡் பியவஹ, ஑வஹ கஹலியஹனவஹ ஑ன் பதஹை வஹைத் துே சஹல் ஢ ஡஢ிய஡ம் .

பின் குறிப்பு: 12ம் வகுப்பு தமிழ் பாட புத்தகத்தை இன்று இணையத்தில் பார்த்த பொழுது, அதில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் இவ்வை.

1. Band Gap - விலக்கப் பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி (forbidden energy gap)
2. Energy band - ஆற்றல் பட்டை
3. Conducting band - கடத்தும் பட்டை

Written by
Saturday, 20 September 2008 15:48 -

4. Valence Band - இணைதிறன் பட்டை
5. intrinsic semiconductor - உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி
6. extrinsic semiconductor - புறவியலான குறைகடத்தி
7. free electron -கட்டிற்றா எலக்ட்ரான்
8. donor atom -கொடன அணு
9. donor level - கொடன மட்டம்
10. acceptor atom -ஏற்பான் அணு
11. acceptor level-ஏற்பான் மட்டம்
12. hole (as in electron/hole)- மின் துளைய
13. depletion region - இயக்கமில்லா பகுதி
14. Junction - சந்தி
15. carrier - ஊர்தி
16. majority carrier - பெரும்பான்மை ஊர்தி
17. minority carrier - சிறுபான்மை ஊர்தி
18. potential barrier - மின்னழுத்த அரண்
19. forward bias - முன்னோக்கு சார்பு
20. reverse bias - பின்னோக்கு சார்பு
21. saturation current -தவிவிட்டு மின்னோட்டம்
22. leakage current - கசிவு மின்னோட்டம்
23. rectification - திருத்துதல்

<http://fuelcellintamil.blogspot.com/2008/02/semiconductor-resistance.html>